

| | |
|---|--|
|  | <p>Hersteller-Teilenummer: BUK652R1-30C,127</p> |
| | <p>Hersteller / Marke: NXP Semiconductors / Freescale</p> |
|  | <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 120A TO220AB</p> |
| | <p>Datenblätter:  BUK652R1-30C,127.pdf</p> |
| | <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> |
| | <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> |
| | <p>Liefern von: Hong Kong</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |



Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | BUK652R1-30C,127 |
| Hersteller | NXP Semiconductors / Freescale |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 30V 120A TO220AB |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 2.8V @ 1mA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-220AB |
| Serie | TrenchMOS™ |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 2.4 mOhm @ 25A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 263W (Tc) |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | TO-220-3 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 10918pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 168nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 30V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 120A (Tc) |

BUK652R1-30C,127 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BUK652R1-30C,127-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BUK652R1-30C,127 NXP Semiconductors / Freescale mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ BUK652R1-30C,127 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|--|---|---|
| <p>sein:</p>  <p>BUK652R3-40C,127 NXP USA Inc. MOSFET N-CH 40V 120A TO220AB</p> |  <p>BUK652R0-30C NXP BUK652R0-30C NXP</p> |  <p>BUK652R6-40C,127 NXP Semiconductors / Freescale MOSFET N-CH 40V 120A TO220AB</p> |  <p>BUK652R7-30C NXP BUK652R7-30C NXP</p> |
|  <p>BUK652R6-40C NXP BUK652R6-40C NXP</p> |  <p>BUK6510-75C,127 NXP USA Inc. MOSFET N-CH 75V 77A TO220AB</p> |  <p>BUK652R3-40C N BUK652R3-40C N</p> |  <p>BUK652R1-30C NXP BUK652R1-30C NXP</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---|------------------------------|-------------------------------|------------------------|---|
| BUK652R1-30C,127 NXP Semiconductors / Freescale | BUK652R1-30C,127 Datenblatt | BUK652R1-30C,127-Datenblätter | BUK652R1-30C,127 PDF | NXP Semiconductors / Freescale BUK652R1-30C,127 |
| BUK652R1-30C,127 Electronic | BUK652R1-30C,127-Komponenten | BUK652R1-30C,127-Verteiler | BUK652R1-30C,127-Bild | BUK652R1-30C,127-Teil |
| BUK652R1-30C,127 Preis | BUK652R1-30C,127 Hersteller | BUK652R1-30C,127 Bild | BUK652R1-30C,127 Aktie | BUK652R1-30C,127 Inventar |
| BUK652R1-30C,127 Neu | BUK652R1-30C,127 Original | BUK652R1-30C,127 garantiert | BUK652R1-30C,127 RFQ | BUK652R1-30C,127 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited